2　特定半導体生産施設整備等計画の目標

3　特定半導体生産施設整備等計画の内容及び実施期間

⑴　特定半導体生産施設整備の内容

㈠　施設概要

施設の名称				
施設の所在地（住所）（注２）				
敷地面積		㎡	建築面積	㎡
主要製品				
生産能力（想定する稼働率）	（　　）		万枚／月（12インチ換算）（％）	
総従業員数（注３）（うち技術者数）	（　　）		人	

（注２）　土地・建物の所有関係に関する資料、工場等の配置図、設計図、設備の配置図を提出すること。

（注３）　生産開始時に予定する従業員の人数を記載すること。

㈡　事業実施期間

	投資着手（発注）	建物新設、設備設置	操業開始
特定半導体生産施設整備	年　月	年　月～　年　月（最短で▲ヶ月間必要）	年　月

⑵　特定半導体生産施設における生産の内容

㈠　施設で生産を行う半導体に関する内容

種類（注４）	性能に関する説明（注５）（注６）

（注４）　演算を行う半導体（トランジスター上に配置される導線の中心の間隔が最も短い箇所において百ナノメートル以下）、記憶を行う半導体（一ビットの情報の記憶に必要な電子回路の面積が千三百七十平方ナノメートル以下）、記憶を行う半導体（積層された一ビットの情報の記憶に必要な電子回路の層の数が百六十以上）のいずれかから選択し記載すること。

（注５）　生産予定の製品が政令で定める要件を満たす旨を記載すること。また、生産予定の製品が記載する性能を満たすことを示す書類を認定計画申請時及び初回の製品生産時に提出すること。

（注６）　生産予定の製品が「演算を行う半導体（トランジスター上に配置される導線の中心の間隔が最も短い箇所において百ナノメートル以下）」の場合は、ゲート絶縁膜に比誘電率が７を超える材料を用いるための装置を使用して生産することを示す書類及び当該生産に係る特定半導体生産施設整備等計画を申請する事業者のうち１以上の事業者がFinFET構造の演算を行う半導体を生産できると認められる技術水準を有することを示す書類を提出すること。

生産予定の製品が「記憶を行う半導体（一ビットの情報の記憶に必要な電子回路の面積が千三百七十平方ナノメートル以下）」の場合は、当該生産に係る特定半導体生産施設整備等計画を申請する事業者のうち１以上の事業者が極端紫外線を用いて露光できると認められる技術水準を有することを示す書類を提出すること。

㈡　特定半導体生産施設整備等計画の下での事業実施期間

	初回出荷	継続生産
特定半導体生産施設における生産	年　月	年　月～　年　月

㈢　製品の納入先に関する説明

⑶　指針適合性の確保

項目		確保措置の内容（注７）
整備適合性	必要な設備の整備	□　特定高度情報通信技術活用システムの開発供給等の促進に関する指針（以下「指針」という。）第四　一　２に掲げる設備の整備を含んでいる。
	指針に適合する設備の整備	□　整備する設備は指針第四　一　３に掲げるいずれかに含まれる。
	指針に適合する施設の整備	□　整備する施設は指針第四　一　４に掲げるいずれかに含まれる。